附件：

审定、预审和讨论的标准项目

| 序号 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 主编单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组 |
|  | 国标委发〔2024〕16号20240139-T-469 | 硅外延用三氯氢硅中杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 洛阳中硅高科技有限公司 | 审定 |
|  | 国标委发〔2024〕16号20240143-T-469 | 重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的测试 红外反射法 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 | 审定 |
|  | 国标委发〔2024〕16号20240496-T-469 | 半导体晶片近边缘几何形态评价 第2部分：边缘卷曲法（ROA） | 山东有研半导体材料有限公司 | 审定 |
|  | [国标委发〔2024〕44号](http://zxd.sacinfo.org.cn/gb_notice/1727662175388.doc%22%20%5Ct%20%22https%3A//std.samr.gov.cn/noc/search/_blank)20243061-T-469 | 300 mm硅外延片 | 浙江丽水中欣晶圆半导体科技有限公司 | 预审 |
|  | [国标委发〔2025〕3号](http://zxd.sacinfo.org.cn/gb_notice/1727662175388.doc%22%20%5Ct%20%22https%3A//std.samr.gov.cn/noc/search/_blank)20250087-T-469 | 集成电路用高纯硅靶材 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 讨论 |
|  | 中色协科字〔2024〕80号[2024-063-T](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=20240075TYS)/CNIA | 半导体外延用等静压石墨 | 四川福碳新材料科技有限公司 | 预审 |
| 第二组 |
|  | 国标委发〔2024〕16号20240137-T-469 | 蓝宝石图形化衬底表面图形几何参数的测定方法 | 广东中图半导体科技股份有限公司 | 预审 |
|  | [国标委发〔2025〕3号](http://zxd.sacinfo.org.cn/gb_notice/1727662175388.doc%22%20%5Ct%20%22https%3A//std.samr.gov.cn/noc/search/_blank)20250093-T-469 | 氮化铝单晶复合衬底 | 松山湖材料实验室 | 讨论 |
|  | 国标委发〔2024〕28号20241934-T-469 | 太阳能电池用砷化镓单晶及抛光片 | 南京集溢半导体科技有限公司 | 预审 |
|  | [国标委发〔2024〕44号](http://zxd.sacinfo.org.cn/gb_notice/1727662175388.doc%22%20%5Ct%20%22https%3A//std.samr.gov.cn/noc/search/_blank)20243065-T-469 | 激光器外延芯片用砷化镓衬底 | 广东先导微电子科技有限公司 | 预审 |
|  | 工信厅科〔2024〕18号2024-0218T-YS | 高纯砷 | 峨眉山嘉美高纯材料有限公司 | 审定 |